

Title (en)
Supporting substrate for a linear potentiometer, and process for its production.

Title (de)
Trägersubstrat für Linearpotentiometer und Verfahren zu seiner Herstellung.

Title (fr)
Substrat de support pour un potentiomètre linéaire et procédé pour sa fabrication.

Publication
EP 0369290 A2 19900523 (DE)

Application
EP 89120568 A 19891107

Priority
DE 3838662 A 19881115

Abstract (en)
Method for producing a supporting substrate for a linear potentiometer and supporting substrate produced in accordance with the method, on which substrate a collector track and/or resistance track is applied preferably in the form of conductive plastic layers. At least one silver-plated stranded copper wire is drawn into the synthetic resin section of the supporting substrate directly during its production, preferably together with glass fibre bundles reinforcing this section, in such a manner that this stranded wire is used for supplying the potentiometer voltage to the facing-away end of the resistance track over the length of the linear potentiometer, in which arrangement, furthermore, a further silver-plated stranded copper wire can be placed underneath the collector track area. The embedded stranded copper wires form a smooth transition to the adjoining section parts.
<IMAGE>

Abstract (de)
Verfahren zur Herstellung eines Trägersubstrats (10) bei Linearpotentiometern und nach dem Verfahren hergestelltes Trägersubstrat (10), auf welchem, vorzugsweise in Form von Leitplastikschichten Kollektorbahn und/oder Widerstandsbahn aufgebracht ist. In das Kunstharzprofil des Trägersubstrats ist unmittelbar bei dessen Herstellung vorzugsweise zusammen mit dieses Profil verstärkenden Glasfaserbündeln mindestens eine versilberte Kupferlitze (12) so eingezogen, daß diese der Zuführung der Potentiometerspannung zum abgewandten Ende der Widerstandsbahn über die Länge des Linearpotis dient, wobei ferner dem Kollektorbahnbereich eine weitere versilberte Kupferlitze (12a) unterlegt sein kann. Die eingelagerten Kupferlitzen bilden einen glatten Übergang zu den angrenzenden Profiltteilen.

IPC 1-7
H01C 10/38

IPC 8 full level
G01R 17/20 (2006.01); **H01B 5/08** (2006.01); **H01C 10/38** (2006.01); **H01C 17/06** (2006.01)

CPC (source: EP)
H01C 10/38 (2013.01); **H01C 17/06** (2013.01)

Citation (applicant)
• DE 3406366 A1 19850822 - NOVOTECHNIK KG OFFTERDINGER [DE]
• US 3036284 A 19620522 - ALEXANDER JOHN W, et al
• DD 211421 A1 19840711 - SPEZIALWIDERSTAENDE VEB [DD]
• DE 1515625 A1 19690814 - DINTER DR ING KONRAD
• DE 2358004 A1 19750522 - LICENTIA GMBH

Cited by
EP4191616A1

Designated contracting state (EPC)
AT FR GB IT

DOCDB simple family (publication)
EP 0369290 A2 19900523; **EP 0369290 A3 19900829**; DE 3838662 A1 19900517; JP H02222841 A 19900905

DOCDB simple family (application)
EP 89120568 A 19891107; DE 3838662 A 19881115; JP 29514489 A 19891115